1Pa023

した。S1 およ

ジフェニルアセチレンの光化学的挙動に関する

理論的研究

(秋田大工学資源) 〇天辰禎晃 細川将

【序論】 π電子共役系を有する分子の光化学的挙動は基礎的な分光学のみならず、光機能性材料 などの材料工学的側面からも大いに関心がもたれている。本発表においては、液晶分子の観点か らも興味が持たれ、分光学的な研究も数多くありながら、その光化学的描像に関して明確でない 点も多いジフェニルアセチレン (DPA: 図1)の電子励起状態を非経験的分子軌道法により理論的 に検討した結果を報告する。

【計算方法】CASSCF 法により DPA の S₀の最安定 構造を求め、その点における電子励起状態の特徴 H^{4} -を検討した。次に D_{2h} の条件下で、S₁から S₄の 安定構造、さらに幾何学的制限なしでの S₁の最安定



構造を求めた。これらをもとに、フランクーコン 図1 ジフェニルアセチレン (DPA) ドン領域から S_1 の最安定構造に至るまでの電子

状態およびその幾何学的変化について追跡した。また、これらに対しては必要に応じ、MRMP2 法によりエネルギーの補正を行った。なお、CASSCFの規模は予備的 CI 計算から 10 電子 10 軌 道で、用いた基底関数は DZP である。

【計算結果】まず、はじめに DPA の S₀の安定構造を求め、D_{2h}の対称性を有していることが分 かった。表1にはその主な最適化パラメーターを示す。C^{α} =C^{α}[']結合は三重結合であり、ベンゼン 環部分は芳香族ベンゼンのそれに近い。また、それを結びつける結合 C¹-C^{α}(C¹-C^{α})は通常の C-C 単結合よりも若干短くなっており、ベンゼン環部分と C^{α} =C^{α}[']の共役による効果と解釈できる。 表2にはこの構造における各状態の対称性、性質の帰属と MRMP2 補正後の励起エネルギーを示

\mathcal{O} S ₂ はそれぞ							
れベンゼン環		A_{g}	B_{2u}	${ m B}_{ m 3g}$	B_{1u}	A_u	
のπ-π*励起							
による B _{2u} 、	Bond distances	s (in Å)					
B _{3g} に帰属でき	$R(C^{\alpha}-C^{\alpha'})$	1.204	1.217	1.217	1.260	1.290	
る。このことは、	$R(C^{1}-C^{\alpha})$	1.449	1.409	1.410	1.380	1.382	
表 1 の S_1 、 S_2	$R(C^{1}-C^{2})$	1.402	1.439	1.439	1.432	1.427	
の安定幾何学	$R(C^{2}-C^{3})$	1.395	1.423	1.423	1.382	1.388	
配置にも反映	R(C ³ -C ⁴)	1.390	1.387	1.388	1.401	1.393	
されている。す							

表 1 Characteristic optimized parameters of DPA under D_{2h}

						0 1	0	
もベンゼン環部分								
が肥大している。一	ş	symmet	ry	assignment	excitat	ion energ	y (in eV)	
方、遷移強度が第一								
励起状態圏で大き	\mathbf{S}_0	A_{g}				0.0		
な B _{1u} を有する S ₃	S_1	$\mathrm{B}_{2\mathrm{u}}$	π-1	π * within benze	ne rings	4.185		
の安定構造は三重	${ m S}_2$	$\mathrm{B}_{3\mathrm{g}}$	π-1	τ * within benze	ne rings	4.194		
結合部分が長くな	\mathbf{S}_3	B_{1u}	HC	OMO-LUMO		4.505		
り、ベンゼン環部分	${ m S}_4$	A_u	in-	plane π -LUMO		5.511		
の芳香族性が消失								
したキノイド構造								

で特徴付けられる。

なわち、 S_1 、 S_2 と 表 2 Electronic structure of DPA at the S_0 -equilibrium geometry

これは S₃が HOMO-LUMO の一電子励起によってよく記述されることを考えれば、その形状に よっても合理的に解釈される。 A_u 対称性を有する S_4 は三重結合の面内 π 電子軌道から LUMO \sim の一電子励起によってよく記述される。 S_3 が、いわば、三重結合の面外 π 電子軌道から LUMO への一電子励起によるものであると言えることから、S3とS4は類似した電子励起状態として帰属 できる。

次に、S1の大域的な安定構造を求めた。その結果、C2hの対称性を有することが分かった。そ の主な最適化パラメーターを表3にまとめた。C-C 結合が二重結合的な長さになった、トランス 屈曲形構造で特徴付けられる。

Bond distances (in Å)								
$R(C^{\alpha}-C^{\alpha'})$	1.357	$R(C^{1}-C^{\alpha})$	1.425	$R(C^1-C^2)$	1.422			
$R(C^2-C^3)$	1.388	R(C ³ -C ⁴)	1.404	R(C ⁴ -C ⁵)	1.392			
$R(C^{5}-C^{6})$	1.384							
Bond angles (in degree)								
$\alpha (< C^1 C^{\alpha} C^{\alpha'})$	127.9							

表 3 Characteristic optimized parameters of DPA in S_1 in A_u under C_{2h}

以上の結果は実験値とも良い一致を示している。実験の励起エネルギーは計算の主遷移 So-S3 のそれに近く、また各状態における 安定構造で求めた回転定数は実験結果をよく再現していた。 また、S1のトランス屈曲形最安定構造を含めて、それぞれの構造での分子内力場の計算を行った ところ、FC 領域における S₀、B₁uの安定状態、S₁の大域的安定構造における振動数が実験のそ れをよく再現していることが分かった。なお、B_{1u}の安定状態は電子励起直後数ピコ秒間過渡的に 観測されるものと解釈される。

これらの結果をもとに、FC 領域での S₃への励起から S₁の大域的安定構造へ至る反応経路につ いては当日発表する。